### 超短パルスレーザー加工の統合シミュレーションコードの開発

古河裕之<sup>1)</sup>、長友英夫<sup>2)</sup>、三間圀興<sup>3)</sup>、矢花一浩<sup>4)</sup>、藤田和久<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> レーザー総研、<sup>2)</sup> 阪大レーザー研、<sup>3)</sup> 光産創大、<sup>4)</sup> 筑波大学計算科学研究センター

## 1. はじめに

超短パルスレーザー加工では、レーザーの吸収は 厚さ数十 nm の層で生じ、ピコ秒のオーダーで変化 する混相状態物質と、超短パルスレーザーとの相互 作用の理解が重要である。この吸収過程とその後の 輻射流体運動の結果である、アブレーションや溶融 層の生成と凝固を記述する統合シミュレーションコ ードの開発を目指す。図1は、開発する統合シミュ レーションコードの構造である。



図1 開発する統合シミュレーションコードの構造



図2 LAPSIC シミュレーションの流れ

図2は、LAPSIC シミュレーションの流れであり、 図3は、レーザー加熱に伴って生成される多階層状 態の構造の1例である。

統合シミュレーションコードの開発においては、 極めて重要な役割を果たしている混相状態とレーザ ーの相互作用の物理を解明し、モデル化することに より、色々な照射条件での短パルスレーザー加工に 適用可能なシミュレーションコードの開発を目指す。



本年度は、固体とレーザーの相互作用の初期過程 の解明に注視した。固体は、原子が結晶構造を組ん でおり、電子の波動関数に周期性が表れ、所謂バン ド構造を形成する。結晶中の電子の波動関数は、ブ ロッホの定理で表される関数形を持つ。

$$\varphi_{\mu}(\mathbf{r} - \mathbf{t}_{n}) = \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{t}_{n})\varphi_{\mu}(\mathbf{r})$$
(1)

第2章で、結晶中の波動関数の簡単な例として、 クローニッヒ・ペニーモデルについて述べる。

#### 2. クローニッヒ・ペニーモデル

レーザー場と相互作用する電子状態を記述する簡 易モデルとして、図4のような井戸型の障壁が周期 的に並んだポテンシャル中の電子状態を考えた。高 さが  $V_0$  で 幅が b, 周期が L=a+bの井戸型のポ テンシャルで、幅 b は b << a とすると、電子状態 はポテンシャルの高さと幅の積  $V_0 b$ 、で決まる。積  $V_0 b$  はポテンシャル障壁の強さと呼ばれる。



図4 井戸型の障壁をもつポテンシャル

上記ポテンシャル中では以下のように比較的簡単 に、conduction band ( $E > V_0$ ) に相当する波動関数を 求めることができる。電子のシュレディンガー方程 式は以下のように書ける。

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{d^2\varphi_1(x)}{dx^2} = E\,\varphi_1(x) \qquad 0 \le x \le a \tag{2}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{d^2}{dx^2}+V_0\right]\varphi_2(x)=E\varphi_2(x) \quad -b\leq x\leq 0$$

$$\varphi_2(x) = \mathcal{C}_2^{i\rho} e^{x} + \overline{\mathcal{C}}_2^{\rho} e^{x} \leq \mathbf{40}$$

$$\alpha = \sqrt{2E}$$
(5)

$$a \sqrt{2L} \tag{6}$$

$$\beta = \sqrt{2(E - V_0)} \tag{7}$$

周期境界条件とブロッホの定理から、次の関係式が導ける。

(8) 式が有意な解を持つためには、行列式が 0 で なければならない。

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ \alpha & -\alpha & -\beta & \beta \\ e^{i\alpha a} & e^{-i\alpha a} & -\lambda e^{-i\beta b} & -\lambda e^{i\beta b} \\ \alpha e^{i\alpha a} - \alpha e^{-i\alpha a} - \lambda \beta e^{-i\beta b} & \lambda \beta e^{i\beta b} \end{vmatrix} = 0$$
(10)

(10) 式から(11) 式が得られる。  

$$\cos\sqrt{2Ea} \cdot \cos\sqrt{2(E-V_0)}b$$

$$-\frac{2E-V_0}{2\sqrt{E(E-V_0)}}\sin\sqrt{2Ea} \cdot \sin\sqrt{2(E-V_0)}b$$

$$=\cos kL$$
(11)

**Valence band** の場合も同様にして、E と k の関係 式が求められる。(12) 式に示す。

$$\cos\sqrt{2E}a\cosh\sqrt{2(V_0 - E)}b + \frac{V_0 - 2E}{2\sqrt{E(V_0 - E)}}\sin\sqrt{2E}a\sinh\sqrt{2(V_0 - E)}b$$
$$= \cos kL$$
(12)

図5は、 $V_0 = 1$ 、L = 7.6521(アルミの格子定数)、 $a = L \times 0.9$ 、b = L - aとして得られたバンド構造である。



図5 得られたバンド構造

#### 3. 時間依存密度汎関数理論

超短パルス光と物質の相互作用、特にパルス光が 照射した直後の電子状態や、光から電子へのエネル ギー移行を正確に見積もるための有効な手法として、 第一原理計算手法である時間依存密度汎関数理論が 挙げられる[1]。本年度は、筑波大学計算科学研究セ ンターの矢花教授にご講演いただき、高強度パルス 光が物質中をどのように伝搬するのか、また光から 物質中の電子にエネルギーが移行する様子について、 有意義な知見を得た。図6は、時間依存密度汎関数 理論による光の物質中での伝搬と吸収に関する解析 の流れの概略図である。



図 6 時間依存密度汎関数理論による光の物質 中での伝搬と吸収に関する解析の流れの概略図

# REFERENCE

[1] 矢花一浩; レーザー研究 44 (2016) 789-793.